

## 13001L

### 硅 NPN 高压开关晶体管芯片 (4")

#### ■用 途

主要用于节能灯、日光灯电子镇流器及其它开关、振荡电路。

#### ■ 芯片示意图



#### ■ 芯片结构

芯片尺寸	820μm×820μm
压焊区尺寸	基 区 130μm×130μm 发射区 135μm×135μm
芯片厚度	220±10μm
锯片槽宽度	60μm
金属层	正面: Al 2.7±0.3μm 背面: Au 1.2±0.2μm 或 Ag 1.4±0.2μm

#### ■ 电特性(T<sub>a</sub>=25℃)

项 目	符 号	测 试 条 件	最小值	最大值	典型值	单位
集电极-基极反向电流	I <sub>CB0</sub>	V <sub>CB</sub> =600V		1		μA
发射极-基极反向电流	I <sub>EB0</sub>	V <sub>EB</sub> =7V		1		μA
集电极-基极击穿电压	BV <sub>CB0</sub>	I <sub>C</sub> =0.1mA	600		750	V
集电极-发射极击穿电压	BV <sub>CEO</sub>	I <sub>C</sub> =1mA	400		430	V
发射极-基极击穿电压	BV <sub>EBO</sub>	I <sub>E</sub> =0.1mA	7			V
直流电流增益	h <sub>FE</sub>	V <sub>CE</sub> =10V, I <sub>C</sub> =50mA	10	40		
集电极-发射极饱和电压	V <sub>CE(sat)</sub>	I <sub>C</sub> =50mA, I <sub>B</sub> =10mA		0.6		V